

张静

张静，教授。

主要从事于硅基SiC功率器件的研究，以及集成电路相关的测试工作，先后为多家半导体相关的科研院所进行器件电学特性测试、数模混合集成电路系统的验证性分析、开关类电源管理wafer的测试等。先后承担了国家自然科学基金一项：《高k栅介质/金属栅结构CMOS器件的界面特性与有效功函数控制技术的基础研究》，作为课题负责人参与了国家科技部重大专项一项：《SiC 电力电子器件集成制造技术研发及产业化》。同时参与了重大专项《高端射频与数字集成电路测试系统》的向量转换问题的研究。获《开关类电源管理集成电路IP的设计与开发》获北京市科技进步三等奖，并荣获甘肃省三八红旗手、北京市师德先进个人等称号。



个人简历

1992.9-1996.6 兰州大学物理系金属物理专业学习，获理学学士学位

1994.9-1996.7辅修兰州大学计算机应用专业

2000.9- 2003.7 兰州大学物理与科学技术学院电子器件与材料工程专业攻读 硕士研究生，主要从事微电子与信息功能材料等方面的研究

教授课程

《半导体物理》、《微电子物理基础》、《电子器件》和《微电子核心课提高》

主要研究领域和方向

1. 半导体材料与电子器件集成
2. 宽禁带半导体材料与MOS器件界面态的研究
3. 生物传感器的研究

4. 集成电路互连Low K介质的研究
5. 集成电路测试方法学研究

近五年的荣誉成果

主持国家自然科学基金1项：2017面上项目，62万元；

主持科技部重大专项1项（子课题负责人），83.22万元；

承担国家自然科学基金1项：2012面上项目，25万元；

近五年共发表论文20余篇，其中SCI、EI期刊论文15篇，（其中第一作者2篇，通讯作者5篇）；

近5年纵向科研到款173.31万，横向科研到款60.5万元。

近年来主要科研项目

课题名称	金额	年份	性质
《高k栅介质/金属栅结构CMOS器件的界面特性与有效功函数控制技术的基础研究》	25万	2012-2015	国家自然科学基金
《SiC 电力电子器件集成制造技术研发及产业化（项目编号：2013ZX02501）》	82.33万	2013-2017	科技部重大转型
《Ge MOSFET迁移率库伦散射机制的研究》	62万	2017-2019	国家自然科学基金
《基于自主工艺平台和国产化材料的碳化硅器件研制》	10万	2016-2017	横向

《AVS漏洞检测系统开发》	50万	2016	横向
---------------	-----	------	----

近年来出版的主要教材与专著

《半导体物理与器件考研辅导》、《微电子物理基础》

在研主要项目

国家自然科学基金：Ge基MOS器件迁移率的远程库仑散射机制的研究

国内外学术活动
